

高纯Ptfе晶圆清洗篮 耐酸硅晶圆载具 含氟聚合物蚀刻架

货号: PL-CP284



简介

我们的高纯PTFE晶圆清洗篮可确保半导体加工无污染，专为强蚀刻和清洗工艺设计。这些可定制载具具备出色的耐化学腐蚀性与热稳定性，可满足湿法化工生产关键环节中硅晶圆片操作的需求。

了解更多

应用场景	说明	核心优势
RCA标准清洗	依次进行SC-1和SC-2清洗步骤，去除硅晶圆上的有机残留物和金属污染物。	防止金属离子浸出，确保超纯加工环境。
食人鱼蚀刻	使用硫酸和过氧化氢混合物去除重质有机物和光刻胶。	可承受极端放热反应和强氧化作用，不发生降解。
氢氟酸浸泡/蚀刻	使用氢氟酸溶液去除牺牲氧化层或自然氧化物。	完全抗氢氟酸腐蚀，不会像玻璃或石英载具那样被损坏。
太阳能电池制绒	将硅晶圆浸入碱性或酸性溶液，形成陷光表面结构。	可实现高产量，耐浓KOH或NaOH溶液腐蚀。
CMP后清洗	去除化学机械抛光后残留的浆料颗粒和化学残留物。	不粘表面可防止浆料重新沉积在载具和晶圆上。
光刻工艺	使用强有机溶剂和显影液进行显影和去胶步骤。	超声波清洗
砷化镓加工	光电子领域化合物半导体基材的湿法化学蚀刻和清洗。	在关键制造步骤中为脆性基材提供温和和牢固的支持。

在水溶液中对精密电子元件进行高频声波清洗。

可有效传递超声波能量，同时保护元件免受机械冲击。

参数	说明/规格 (PL-CP284系列)
产品编号	PL-CP284
主要材料	高纯原生PTFE (聚四氟乙烯)
化学兼容性	通用型 (强酸、强碱、溶剂、氧化剂)
标准晶圆尺寸	兼容4英寸、6英寸和8英寸晶圆
定制选项	尺寸、槽位数量和槽宽均可完全定制
把手配置	固定式、可拆卸式或兼容机械手款式 (可定制)
工作温度	-200°C 至 +260°C (持续工作)
表面处理	高精度CNC加工，低孔隙率表面
槽位设计	V型或定制轮廓，实现最小接触面积
制造工艺	100% CNC加工，确保精度和结构完整性

应用场景	说明	核心优势
参数	说明/规格 (PL-CP284系列)	
纯度等级	痕量分析级，无金属制造工艺	